

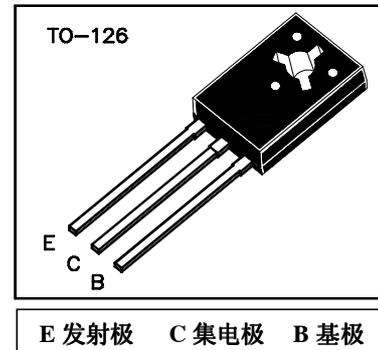
## B772P PNP 功率三极管

### \* 主要用途：

主要用于高频放大电路、应急灯、  
电动玩具控制电路。

### \* 主要特点：

硅外延平面工艺  
输出特性好、电流容量大。

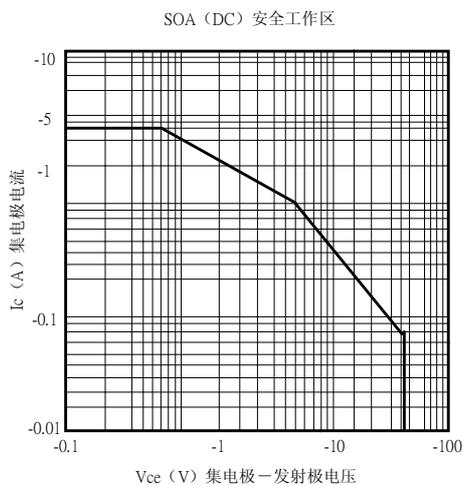
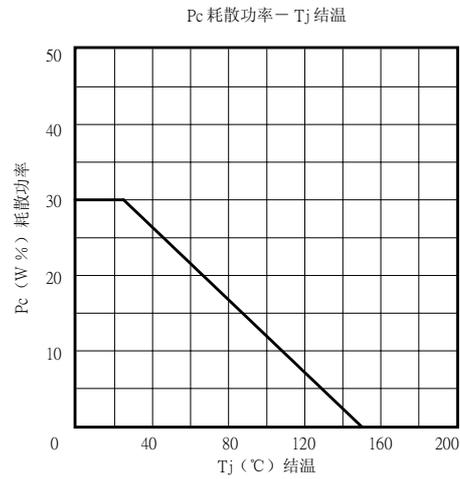
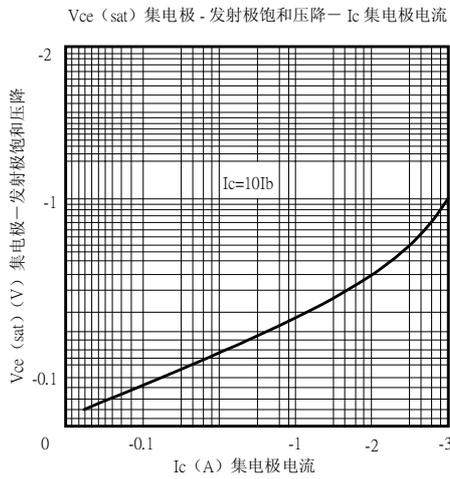
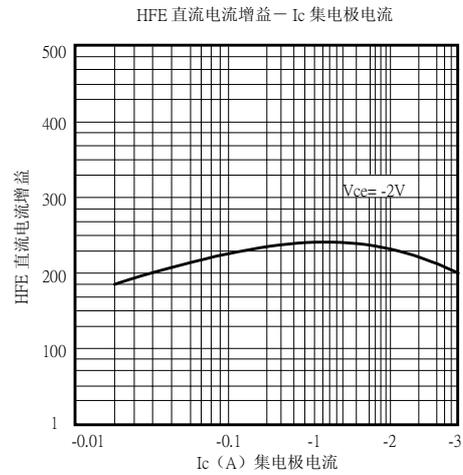
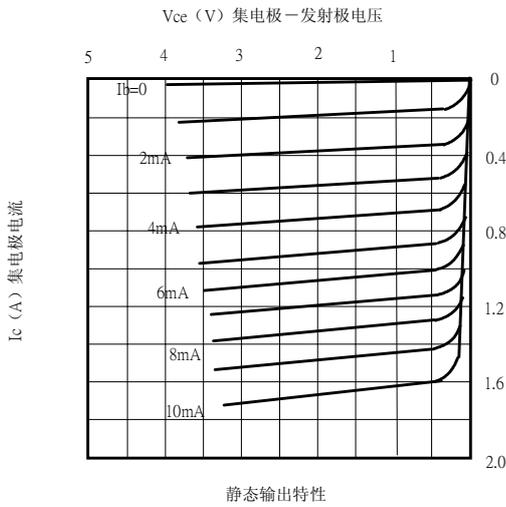
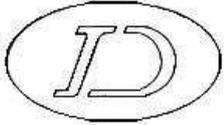


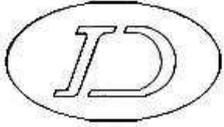
### 极限值：(Tc=25℃)

参数名称	符号	额定值	单位
集电极-发射极击穿电压	$BV_{CEO}$	$\geq -30$	V
集电极-基极击穿电压	$BV_{CBO}$	$\geq -40$	V
发射极-基极击穿电压	$BV_{EBO}$	$\geq -6$	V
最大集电极直流电流	$I_{cm}$	-3	A
最大耗散功率	$P_{cm}$	30	W
最高结温	$T_{jm}$	150	℃
贮存温度	$T_{stg}$	-55 ~ 150	℃

### 电特性：(Tc=25℃)

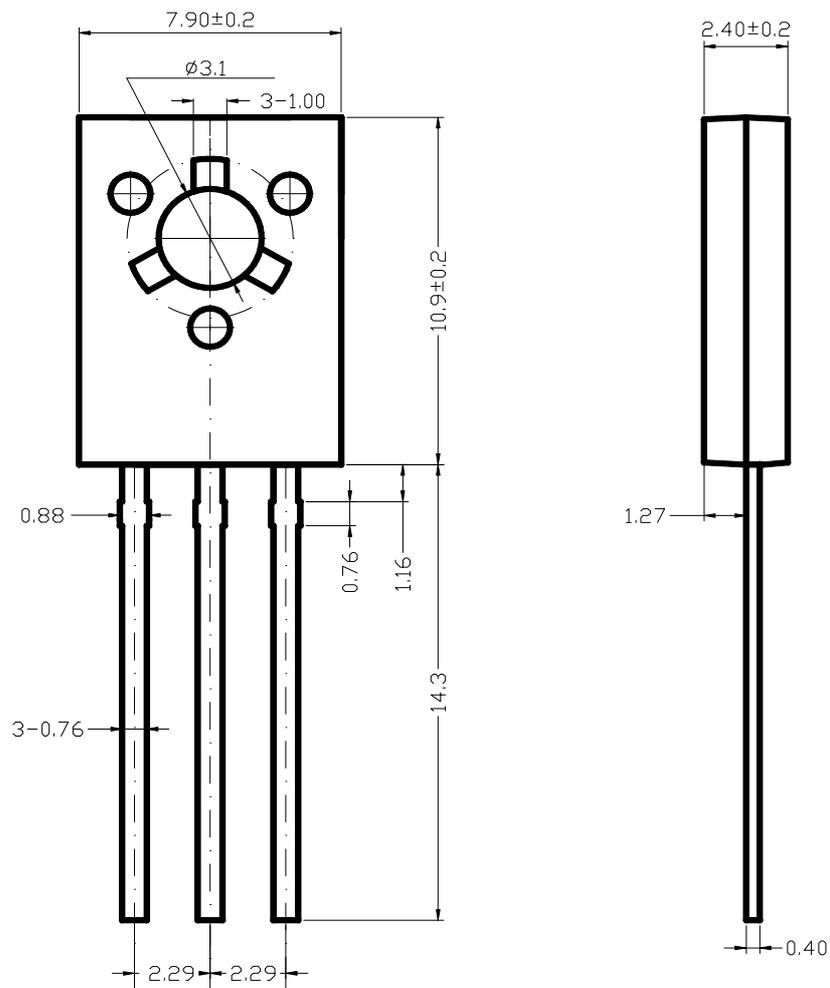
参数名称	符号	测试条件	规范值		单位
			最小值	最大值	
集电极-发射极击穿电压	$BV_{CEO}$	$I_C=-1mA; I_B=0$	-30		V
集电极-基极击穿电压	$BV_{CBO}$	$I_C=-1mA; I_E=0$	-40		V
发射极-基极击穿电压	$BV_{EBO}$	$I_E=-1mA; I_C=0$	-6		V
集电极-发射极反向漏电流	$I_{CEO}$	$V_{CE}=-25V; I_B=0$		-20	$\mu A$
集电极-基极反向漏电流	$I_{CBO}$	$V_{CB}=-35V; I_E=0$		-10	$\mu A$
发射极-基极反向漏电流	$I_{EBO}$	$V_{EB}=-6V; I_C=0$		-10	$\mu A$
共发射极直流电流增益	$H_{FE}$	$V_{CE}=-2V; I_C=-1A$	120	400	
		$V_{CE}=5V; I_C=1mA$	50		
集电极-发射极饱和压降	$V_{CE(sat)}$	$I_C=-2A; I_B=-0.2A$		-0.5	V
下降时间	$t_f$	$I_C=-2A; I_{B1}=I_{B2}=-0.4A; V_{CE}=-20V$		0.2	$\mu S$
特征频率	$f_T$	$V_{CE}=-5V; I_C=-0.1A; f=1MHz$	80		MHz

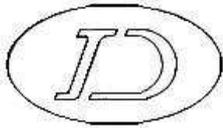




## 封装形式:

**TO-126** (单位: mm, 无其他特别说明公差  $\pm 0.1\text{mm}$ )





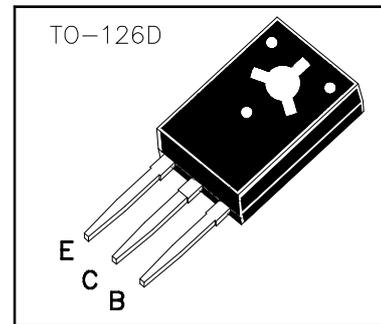
## B772P PNP 功率三极管

### \* 主要用途：

主要用于高频放大电路、应急灯、  
电动玩具控制电路。

### \* 主要特点：

硅外延平面工艺  
输出特性好、电流容量大。



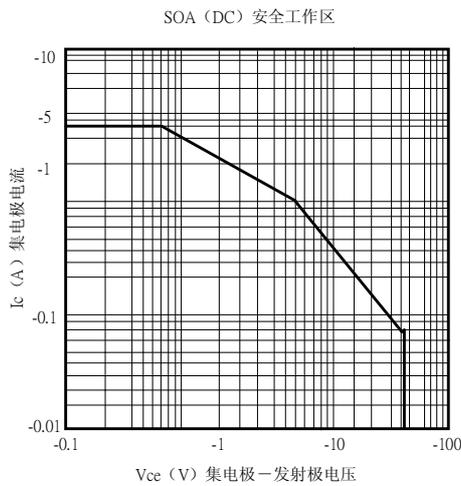
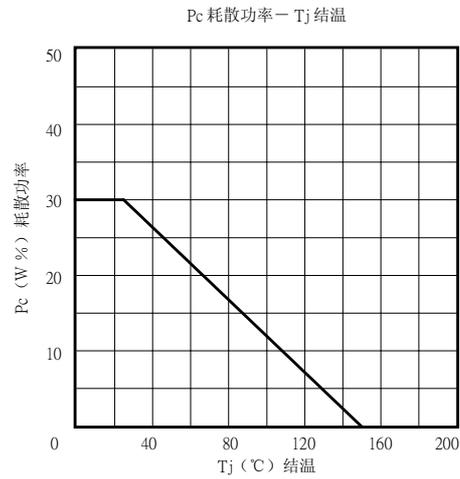
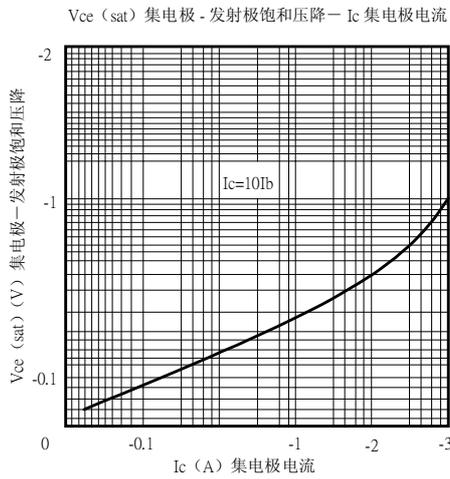
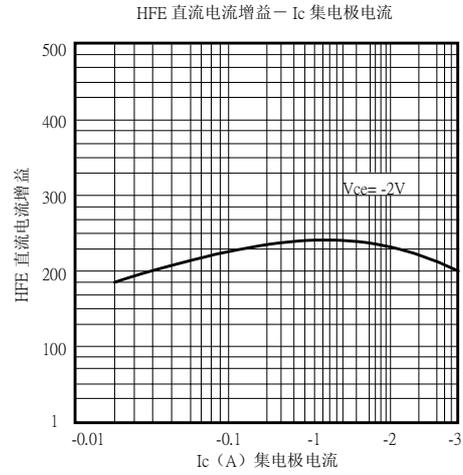
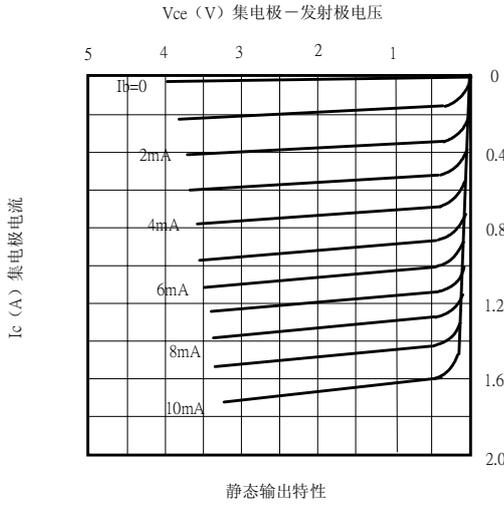
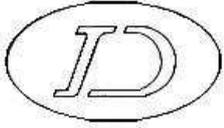
E 发射极 C 集电极 B 基极

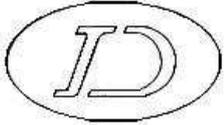
### 极限值：(Tc=25℃)

参数名称	符号	额定值	单位
集电极-发射极击穿电压	$BV_{CEO}$	$\geq -30$	V
集电极-基极击穿电压	$BV_{CBO}$	$\geq -40$	V
发射极-基极击穿电压	$BV_{EBO}$	$\geq -6$	V
最大集电极直流电流	$I_{cm}$	-3	A
最大耗散功率	$P_{cm}$	30	W
最高结温	$T_{jm}$	150	℃
贮存温度	$T_{stg}$	-55 ~ 150	℃

### 电特性：(Tc=25℃)

参数名称	符号	测试条件	规范值		单位
			最小值	最大值	
集电极-发射极击穿电压	$BV_{CEO}$	$I_C=-1mA; I_B=0$	-30		V
集电极-基极击穿电压	$BV_{CBO}$	$I_C=-1mA; I_E=0$	-40		V
发射极-基极击穿电压	$BV_{EBO}$	$I_E=-1mA; I_C=0$	-6		V
集电极-发射极反向漏电流	$I_{CEO}$	$V_{CE}=-25V; I_B=0$		-20	$\mu A$
集电极-基极反向漏电流	$I_{CBO}$	$V_{CB}=-35V; I_E=0$		-10	$\mu A$
发射极-基极反向漏电流	$I_{EBO}$	$V_{EB}=-6V; I_C=0$		-10	$\mu A$
共发射极直流电流增益	$H_{FE}$	$V_{CE}=-2V; I_C=-1A$	120	400	
		$V_{CE}=5V; I_C=1mA$	50		
集电极-发射极饱和压降	$V_{CE(sat)}$	$I_C=-2A; I_B=-0.2A$		-0.5	V
下降时间	$t_f$	$I_C=-2A; I_{B1}=I_{B2}=-0.4A; V_{CE}=-20V$		0.2	$\mu S$
特征频率	$f_T$	$V_{CE}=-5V; I_C=-0.1A; f=1MHz$	80		MHz





## 封装形式:

**TO-126D** (单位: mm, 无其他特别说明公差  $\pm 0.1\text{mm}$ )

